

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年2月5日(2015.2.5)

【公開番号】特開2012-235106(P2012-235106A)

【公開日】平成24年11月29日(2012.11.29)

【年通号数】公開・登録公報2012-050

【出願番号】特願2012-95280(P2012-95280)

【国際特許分類】

H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/8242	(2006.01)
H 01 L	27/108	(2006.01)
H 01 L	21/8244	(2006.01)
H 01 L	27/11	(2006.01)
H 01 L	21/8247	(2006.01)
H 01 L	27/115	(2006.01)
H 01 L	27/105	(2006.01)
H 01 L	27/10	(2006.01)
H 01 L	29/788	(2006.01)
H 01 L	29/792	(2006.01)
H 01 L	21/28	(2006.01)
H 01 L	29/417	(2006.01)
H 01 L	29/423	(2006.01)
H 01 L	29/49	(2006.01)

【F I】

H 01 L	29/78	6 2 6 C
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	29/78	6 1 7 S
H 01 L	29/78	6 1 8 C
H 01 L	29/78	6 1 7 K
H 01 L	27/10	3 2 1
H 01 L	27/10	3 8 1
H 01 L	27/10	4 3 4
H 01 L	27/10	6 1 5
H 01 L	27/10	6 7 1 C
H 01 L	27/10	6 7 1 Z
H 01 L	27/10	4 4 1
H 01 L	27/10	4 8 1
H 01 L	29/78	3 7 1
H 01 L	21/28	3 0 1 B
H 01 L	29/50	M
H 01 L	29/58	G

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月11日(2014.12.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

絶縁層と、酸化物半導体膜と、を有し、
前記絶縁層は、曲面を有する領域を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記絶縁層の曲面に接する第1の領域を有し、
前記第1の領域は、前記絶縁層の曲面に概略垂直なc軸を有する結晶を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

絶縁層と、酸化物半導体膜と、を有し、
前記絶縁層は、曲面を有する領域を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記絶縁層の曲面に接する第1の領域を有し、
前記第1の領域は、前記絶縁層の曲面に概略垂直なc軸を有する結晶を有し、
前記結晶は、前記絶縁層の曲面に沿った層状構造を有することを特徴とする半導体装置
。

【請求項 3】

絶縁層と、酸化物半導体膜と、を有し、
前記絶縁層は、複数のトレンチを有し、
前記トレンチは、下端に曲面を有する領域を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記絶縁層の曲面に接する第1の領域を有し、
前記第1の領域は、前記絶縁層の曲面に概略垂直なc軸を有する結晶を有し、
前記結晶は、前記絶縁層の曲面に沿った層状構造を有することを特徴とする半導体装置
。

【請求項 4】

請求項1乃至3のいずれか一において、
前記絶縁層の曲面は、20nm以上60nm以下の曲率半径を有することを特徴とする
半導体装置。